

第11回九大2D物質研究会

主催：応用力学研究所，共催：日本表面真空学会九州支部

「2D物質の形成と構造・物性評価」

平成31年2月22日（金） 13:00～20:00

於 九大西新プラザ（発表15分+質疑5分=20分）

0. 13:00～13:10

九大院工 田中 悟 教授

「研究会について」

1. 13:10～13:30

九大応力研 教授 寒川 義裕 教授

「窒化物半導体成長モデリングの進展：不純物混入機構の考察」

2. 13:30～13:50

京大院工 船戸 充 准教授

「GaN/AlN 極薄量子井戸構造の光学特性」

3. 13:50～14:10

九大院総理工 水野 清義 教授

「電界放出低速電子回折装置の開発」

4. 14:10～14:30

筑波大院数理物質 神田 晶申 教授

「層状超伝導体原子層膜を用いた渦糸量子状態操作」

5. 14:30～14:50

宇部高専 碓 智徳 教授

「MIESによる異種原子吸着したSiC再構成表面上の電子状態観測」

休憩 14:50～15:10

6. 15:10～15:30

富士電機 藤井 氏

「金属/グラフェン/SiC界面の電気特性とその制御」

7. 15:30～15:50

名古屋大院工 乗松 航 准教授

「SiC上エピタキシャル炭化物からのグラフェン成長」

8. 15:50～16:10

九大 GIC Pablo Solís-Fernández 氏

「Synthesis of AB-Stacked Bilayer Graphene on Cu-Ni Films」

9. 16:10～16:30

島根大院工 影島 博之 教授

「層状物質で覆われたCu表面でのグラフェン成長素過程の理論検討」

10. 16:30～16:50

九大院工 田中 悟 教授

「グラフェン直接転写によるモアレ系積層グラフェンの形成」

11. 16:50～17:10

東大物性研 小森 文夫 教授

「ツイスト2層グラフェンの電子状態」

12. 17:10～20:00

総合討論（終了後懇親会）